# ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И ЯН-ТЕЛЛЕРОВСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ В ФУЛЛЕРЕНОВОМ КОМПЛЕКСЕ С<sup>•–</sup>–МDABCO<sup>+</sup>–ТРС-I

А. В. Кузьмин<sup>а\*</sup>, С. С. Хасанов<sup>а</sup>, Д. В. Конарев<sup>b</sup>

<sup>а</sup> Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна Российской академии наук 142432, Черноголовка, Московская обл., Россия

<sup>b</sup> Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук 142432, Черноголовка, Московская обл., Россия

> Поступила в редакцию 20 октября 2023 г., после переработки 28 ноября 2023 г. Принята к публикации 28 ноября 2023 г.

Методами рентгеноструктурного анализа и квантово-химического моделирования рассмотрен кристалл слоистого органического проводника на основе анион-радикалов фуллерена,  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I. Изучена квазидвумерная электронная структура его проводящих фуллереновых слоев, типы деформации моноанионов  $C_{60}^{\bullet-}$  и причины их возникновения с точки зрения ян-теллеровских взаимодействий. Показано, что кристаллографически неэквивалентные  $C_{60}^{\bullet-}$  характеризуются разными искажениями каркасов, которые являются причиной существенных различий в электронных зонных диаграммах соответствующих фуллереновых слоев.

**DOI:** 10.31857/S0044451024040072

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

Полиароматические анионы с высокой симметрией могут быть основой для создания материалов с необычными физико-химическими свойствами [1]. Например, согласно теоретическим оценкам, основное состояние дианионов может быть триплетным, что перспективно для создания молекулярных магнетиков [2]. Одними из таких полиароматических анионов являются восстановленные формы фуллеренов  $C_{60}^{n-}$ . Получение ионных соединений фуллерена С<sub>60</sub> в кристаллической форме позволило изучать структуру и свойства таких высокосимметричных молекул и комплексов на их основе экспериментально. Например, кристаллы соли  $M_3C_{60}$  (М — металл) с трианионами  $C_{60}^{3-}$  имеют кубическую симметрию и обладают металлической проводимостью. Более того, в этих соединениях наблюдается

переход в сверхпроводящее состояние при температурах 17–33 К [3]. Нейтральный C<sub>60</sub> имеет высокую *I<sub>h</sub>* симметрию и трехкратно вырожденную низшую свободную молекулярную орбиталь (НСМО). При образовании анионов  $C_{60}^{n-}$  в составе сложного ионного соединения НСМО орбиталь фуллерена заселяется дополнительными *п* электронами. Возможны случаи, когда аниону становится энергетически выгодно определенным образом деформироваться, понизив свою симметрию, и тем самым снять вырождение в своей электронной подсистеме. Такие взаимодействия называются ян-теллеровскими. Они часто наблюдаются в растворах с ионами высокосимметричных молекул, однако могут иметь место и в кристаллических формах ионных соединений, в том числе и в фуллереновых [4].

Представляют интерес слоистые анионрадикальные соли C<sub>60</sub> с гексагональной или тригональной симметрией кристаллов. Кристаллы таких соединений проявляют металлические свойства в широком интервале температур и необычные магнитные состояния с сильной фрустрацией спинов из-за треугольного расположения

E-mail: kuzminav@issp.ac.ru



Рис. 1. a — Слоистая структура кристаллов  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-ТРС-I;  $\delta$  — вид слоя **A** вдоль направления  $c^*$ ; a, b, c — направления кристаллографических осей координат, x, y, z – декартова система координат, соответствующая кристаллографической

С<sub>60</sub> [5–10]. В данной работе детально рассматривается молекулярная и электронная зонная структура фуллеренового анионного комплекса  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I с треугольной подрешеткой С<sub>60</sub><sup>•-</sup>. Уникальной особенностью комплекса является то, что в своем составе помимо фуллерена он имеет только С3-симметричные молекулы: катион MDABCO<sup>+</sup> — N-метилдиазобициклооктана и TPC-I — триптицен-йодида. Использование высокосимметричных противоионов и молекул-спейсеров позволило сохранить высокую симметрию фуллереновых слоев, тем самым открывая возможность формирования нетривиальных коллективных состояний электронов в них. Комплекс изоструктурен ранее изученному кристаллу  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-ТРС-Н [10], за исключением замены одного апикального водорода в молекуле триптицена на атом йода. Было показано, что в случае  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-ТРС-Н фуллереновые слои имеют металлическую проводимость при азотных температурах, диэлектризуются при гелиевых, а при высоких испытывают фазовый переход типа «порядокбеспорядок» с потерей проводимости в одном из слоев [10]. Одной из гипотетических причин особенностей низкотемпературного поведения комплекса могут быть нетривиальные ян-теллеровские взаимодействия, которые возникают в подрешетках анион-радикалов С<sub>60</sub><sup>•-</sup>. Однако на тот момент качество монокристальных структурных данных по  $C_{60}^{\bullet-}$ -МДАВСО<sup>+</sup>-ТРС-Н не позволило надежно оценить параметры искажений каркасов C<sub>60</sub><sup>•-</sup> в интересующих температурных диапазонах и учесть их вклад в электронную зонную структуру кристаллов. В новом же комплексе  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I

с модифицированным триптиценом удалось получить надежные структурные данные с факторами расходимости  $R_1 < 5\%$ . На их основе мы провели сравнительный анализ геометрических искажений каркасов  $C_{60}^{\bullet-}$  и результатов квантово-химических расчетов электронного спектра функциональных фуллереновых слоев.

### 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Кристаллы С<sub>60</sub><sup>•-</sup>-МDABCO<sup>+</sup>-ТРС-І были приготовлены, следуя описанным раннее условиям синтеза [10]. Структурные данные были получены при температуре 120 К на  $K_{\alpha}$ -излучении Мо с использованием лабораторного CCD дифрактометра Rigaku-Oxford Diffraction GeminiR с четырехкружным kгониометром в полной сфере ограничения по вектору рассеяния  $q = 4\pi \sin \theta / \lambda = 8.377 \text{ Å}^{-1}$ , что позволило в дальнейшем анализировать структуру в низкосимметричном приближении. Электронная структура анионов С<sub>60</sub><sup>•-</sup> рассчитывалась расширенным методом Хюккеля (PMX или EHT -Extended Hückel Method) с использованием программного пакета YAeHMOP [11] в базисе атомных s-, p-орбиталей слейтеровского типа, STO-SZ для атомов С, Н, N и STO-DZ для атомов йода I [12]. В качестве входных параметров использовались координаты атомов, полученные из рентгеноструктурного анализа без предварительной оптимизации геометрии. Параметры слейтеровских функций взяты оптимизированными как результат подгонки к расчетам в рамках теории функционала плотности по серии однотипных соединений [13]. Для расчетов зонной структуры, плотности состояний и поверх-



Рис. 2. Зонная структура, плотность состояний (*a*), поверхность Ферми (*б*) и интегралы переноса *t<sub>i</sub>* (*e*) для слоя А кристалла С<sup>6−</sup><sub>60</sub>-MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I

ности потенциальной энергии применялся комбинированный метод — РМХ + метод сильной связи с несмещенной сеткой специальных k-точек плотностью  $11 \times 11 \times 11$ , построенной по схеме Монкхорста – Пака [14].

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

# 3.1. Кристаллическая структура $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I

При комнатной температуре комплекс  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I кристаллизуется в тригональной группе симметрии  $R\bar{3}$  (симметрия позиции фуллерена в кристалле —  $C_{3v}$ ) [10]. В первом приближении указанная тригональная симметрия сохраняется и при низких температурах. Для исключения влияния общей высокой симметрии при анализе молекулярной структуры фуллерена и искажений его каркаса уточнение структуры кристалла в целом проводилось в триклинной установке в приближении симметрии P1. При понижении температуры ниже 200 К наблюдаются слабые искажения решетки, приводящие к понижению симметрии позиции фуллерена до С<sub>i</sub>. При температуре T = 120 К параметры решетки равны a = 9.956(1) Å, b = 9.961(1) Å, c = 28.437(3) Å,  $\alpha = 90.23(1)^{\circ}, \ \beta = 99.65(1)^{\circ}, \ \gamma = 119.95(1)^{\circ},$ V = 2396.8(1) Å<sup>3</sup>, что соответствует примитивной ячейке исходной тригональной решетки. Выбор такой установки обусловлен тем, что в этом случае оси а и в лежат в плоскости фуллереновых плотноупакованных слоев. Структура комплекса аналогична ранее описанной структуре [10] и представляет собой слоистую упаковку анионных фуллереновых  $C_{60}^{\bullet-}$  и катионных MDABCO<sup>+</sup>–TPC-I



Рис. 3. Зонная структура, плотность состояний (*a*), поверхность Ферми (*б*) и интегралы переноса *t<sub>i</sub>* (*в*) для слоя В кристалла С<sup>6−</sup><sub>60</sub>−MDABCO<sup>+</sup>−TPC-I

слоев (см. рис. 1 б, в). Различие в слоях заключается во взаимной ориентации фуллеренов в слое и их катионном окружении. Фуллерены типа **A** упаковываются таким образом, что локально в анионном слое сохраняется ось третьего порядка, а катион MDABCO<sup>+</sup> и TPC-I смотрят апикальными заместителями в противоположные относительно плоскости слоя стороны. Фуллерены типа **B** сориентированы двойной C = C связью в сторону катионного слоя, а метильная группа MDABCO<sup>+</sup> и I смотрят внутрь междоузельного пространства подрешетки фуллеренового слоя.

# 3.2. Электронная структура фуллереновых слоев

Для расчетов зонной структуры слоев **A** и **B** в качестве входных параметров использовались координаты атомов целевого слоя и двух катионных слоев, окружающих этот фуллереновый слой. Такой подход позволяет учесть электростатическое влияние катионов и наиболее корректно оценить распределение заряда в  $C_{60}^{\bullet-}$ .

На рисунках 2 и 3 изображены результаты расчетов зонных структур слоев **A** и **B**. Точками на рис. 2 *a* и рис. 3 *a* показаны дисперсионные кривые, полученные методом РМХ и проходящие через симметричные точки зоны Бриллюэна:  $\Gamma = (0,0,0)$ , X = (1/2,0,0), M = (2/3,1/3,0), R = (1/2,1/2,0),K = (1/3,2/3,0), Y = (0,1/2,0), L = (-1/3,1/3,0).Рисунки 26 и 36 содержат сечения поверхности Ферми в плоскости слоя.

Первичный анализ зонных диаграмм показывает, что для слоя **A** характерны относительно неширокие зоны — 33 мэВ, 50 мэВ и 52 мэВ, низшая, самая узкая из них, является частично заполненной. Плотность состояний на уровне Ферми относительно высока и равна  $0.112 \ \text{эB}^{-1}$  на элементарную ячейку. Узость зоны говорит о слабом электронном взаимодействии между узлами треугольной подрешетки  $C_{60}^{\bullet-}$ .

В слое **B**, наоборот, наблюдается значительное искривление нижней зоны, через которую проходит уровень Ферми (см. рис. 3). Особенно это заметно в направлениях  $\Gamma$ -K-Y, чем и определяются достаточно большие ширины нижней зоны проводимости и двух верхних валентных подзон (81 мэВ, 64 мэВ и 48 мэВ). Плотность состояний на уровне Ферми для слоя **B** почти в два раза ниже таковой для слоя **A** и составляет 0.047 эВ<sup>-1</sup> на элементарную ячейку.

Сплошными линиями на зонных диаграммах (рис. 2 а и рис. 3 а) показаны результаты подгонки дисперсионных кривых, полученных из РМХ, кривыми  $E(\mathbf{k})$ , полученными методом теории сильной связи, где в качестве базиса выступают три орбитали фуллерена  $\phi_0^{\text{HCMO}}, \phi_1^{\text{HCMO}}, \phi_2^{\text{HCMO}}$ . Видно, что метод сильной связи хорошо описывает расчетные кривые РМХ. В нейтральном фуллерене они являются низшими свободными молекулярными орбиталями (НСМО) и трехкратно вырождены в силу икосаэдрической симметрии каркаса C<sub>60</sub>. В анионе C<sub>60</sub><sup>•-</sup> один из уровней НСМО заселяется дополнительным электроном, однако для сохранения аналогии будут использованы те же названия орбиталей. В таком базисе одноэлектронная волновая функция в периодическом потенциале будет представлять собой блоховскую сумму

$$\psi_k(\mathbf{r}) \propto \sum_{n=0}^2 c_n(\mathbf{k}) \sum_{\tau} e^{\mathbf{i}(\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\tau})} \phi_i^{\text{HCMO}}(\mathbf{r}-\boldsymbol{\tau})$$

по базисным функциям n и ближайшим соседям  $\tau$ . Полученные таким образом интегралы переноса между HCMO:

$$t_{\tau}(i \rightleftharpoons j) = \int (\phi_i^{\text{HCMO}}(\mathbf{r}))^* \widehat{H} \phi_i^{\text{HCMO}}(\mathbf{r} - \tau) d\mathbf{r},$$

где

$$\widehat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r})$$

— гамильтониан электрона в периодическом потенциале  $U(\mathbf{r})$ , показаны на рис. 2 *в*.

Видно, что значения  $|t_{\tau}(0 \rightleftharpoons j)|$  между низшими по энергии орбиталями  $\phi_0^{\text{HCMO}}$  не превышают 5 мэВ и близки друг к другу по величине. Это говорит о том, что электроны на фронтальных орбиталях С<sub>60</sub><sup>6-</sup> слабо взаимодействуют друг с другом, поэтому электронная подсистема фуллеренового слоя **A** больше похожа на систему слабовзаимодействующих спинов S = 1/2 в треугольной подрешетке.



Рис. 4. Значения энергии  $e_{ii}$  трех уровней HCMO анионов типа **А** и **В** в кристалле  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I, нижний заселенный уровень аниона отмечен точкой

Энергетическую структуру трех молекулярных орбиталей слоя **A** можно оценить по величине

$$e_{ii} = \int (\phi_i^{\text{HCMO}}(\mathbf{r})) \cdot \hat{H} \phi_i^{\text{HCMO}}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}.$$

На рис. 4 отображены значения  $e_{ii}$  для трех уровней  $\phi_i^{\text{HCMO}}$  и энергии зон в точке Г. Как показывает диаграмма уровней  $e_{ii}$ , в каждом типе анионов три уровня HCMO расщеплены по схеме 2 + 1, когда заселенный электроном уровень понижается по энергии относительно других:  $e_{00} = -9.7724$  эВ,  $e_{11} = -9.7439$  эВ,  $e_{22} = -9.7249$  эВ для слоя **A** и  $e_{00} = -9.7801$  эВ,  $e_{11} = -9.7360$  эВ,  $e_{22} = -9.7219$  эВ для слоя **B**. Данная схема вырождения является типичной для моноанионов  $C_{00}^{60}$  [15].

## 3.3. Деформации в каркасах $C_{60}^{\bullet-}$

Сравнивая электронные структуры двух слоев А и В (в частности, функционально значимой низшей полузаполненой подзоны), можно сделать вывод, что они существенно отличны друг от друга. Причины такого различия могут заключаться в нетривиальных искажениях каркасов базовых анионов  $C_{60}^{\bullet-}$ , имеющих ян-теллеровскую природу. Известно, что связанная с ян-теллеровскими искажениями энергетическая поправка к внутриузельной энергии (на анионе фуллерена) может вызывать смену междоузельных электронных взаимодействий во всем слое [16].

Для характеризации искажения в анионах фуллерена, в том числе и ян-теллеровских, удобно поль-



Рис. 5. Структура деформаций в анионах слоя А : система сферических координат и теоретическая форма одномодовых деформаций анион-радикала относительно сферы [18] (*a*), карта деформаций фуллеренов слоя А, отображающая смещения атомов углерода относительно поверхности сферы  $\Delta r$  (*б*), упаковка анионов А и молекул катионного слоя (*в*), цепочка MDABCO<sup>+</sup> · · · C<sup>•-</sup><sub>60</sub> · · · MDABCO<sup>+</sup> (все расстояния указаны в Å) (*г*);  $\nu_1$ ,  $\nu_2$  и  $\nu_3$  — направления осей аппроксимирующего эллипсоида



Рис. 6. Карта деформаций фуллеренов слоя B, стрелками показаны максимальные оси эллипсоидов анизотропных смещений атомов углерода (*a*), ближайшее окружение фуллерена B в кристалле (все расстояния указаны в Å) (*б*);  $\nu_1$ ,  $\nu_1$  и  $\nu_1$  — направления осей аппроксимирующего эллипсоида

зоваться методом аппроксимации его деформированного каркаса эллипсоидом. Полученные таким образом длины осей эллипсоида  $\nu_1$ ,  $\nu_2$  и  $\nu_3$  позволяют установить основное направление искажений, а разница в длинах осей может быть надежной оценкой степени деформации. Более того, такой подход позволяет описать тонкую структуру деформаций, для чего можно воспользоваться картами деформаций, построенными по отклонению атомов  $C_{60}^{\bullet-}$  от поверхности эквивалентной сферы.

Результаты деформационного анализа каркасов фуллеренов **A** представлены на рис. 5. Средний ра-



Рис. 7. Карта распределения заряда по поверхности фуллерена слоя В

диус ионного фуллеренового каркаса близок к радиусу нейтрального С<sub>60</sub> с оптимизированной геометрией [17] и равен 3.549 Å. Длины осей аппроксимирующего эллипсоида фуллерена из слоя А составляют  $\nu_1 = 3.542$  Å,  $\nu_2 = 3.546$  Å,  $\nu_3 = 3.558$  Å. Таким образом, в первом приближении каркас описывается эллипсоидом вращения. Максимальная по длине ось эллипсоида фуллеренов слоя А («выделенная» ось деформации) — ось  $\nu_3$ , ориентирована вдоль кристаллографического направления [001] и перпендикулярна плоскости фуллеренового слоя (a, b) (рис. 5 e). Кроме того, в структуре деформаций аниона А выделяется узкая экваториальная область сжатия (рис. 5 б), наличие которой было предсказано теоретически [18] (рис. 5 а) и свидетельствует о явном ян-теллеровском характере искажения его каркаса.

Как правило, ян-теллеровские искажения радикалов фуллерена С<sub>60</sub><sup>•-</sup> имеют относительно небольшую в ряду анионов  $C_{60}^{n-}$  величину [16] и плохо распознаются по монокристальным структурным данным, так как часто оказываются подавленными внешними факторами — кристаллическим полем, сильными тепловыми колебаниями и т.д. Однако в случае анионов слоя А они имеют ярко выраженный характер, причиной чему может быть уникальное расположение аниона в структуре. Каждый анион типа А находится в сотах, образованных сеткой молекул TPC-I (рис. 5 в), причем сверху и снизу его окружают катионы MDABCO<sup>+</sup> (см. рис. 5 *г*). В этом случае электростатическое поле катионов не препятствует, а усиливает одноосные янтеллеровские деформации растяжения  $C_{60}^{\bullet-}$ . Такие одноосные деформации не запрещены симметрией слоя (см. рис. 1 б) и допускают свободное вращение фуллерена относительно нормали к плоскости слоя. Однако в нашем случае фуллерен жестко фиксируется в своей ориентации как относительно направлений в плоскости слоев, так и нормали к слоям.

Для полноты картины искажений каркаса фуллерена следует отметить следующие его особенности. Из структурного анализа следует, что атомы углерода фуллерена А характеризуются относительно небольшими по величине параметрами анизотропных смещений, при этом атомы колеблются преимущественно на поверхности фуллеренового каркаса. Тангенциальные оси тепловых эллипсоидов (направления, параллельные поверхности) в два раза превышают радиальную компоненту (направления вдоль радиуса):  $U_{\parallel,1} = 0.163 \text{\AA}^2$ ,  $U_{\parallel,2} = 0.153 \text{Å}^2, U_{\perp} = 0.086 \text{Å}^2$ . По своей сути радиальные составляющие атомных смещений вносят определяющий вклад в распределение деформированных областей сжатия-растяжения каркаса фуллерена, поэтому их подавление может говорить о статическом сформированном характере каркаса и об отсутствии неучтенных в анализе «скрытых» искажений аниона фуллерена.

Форма фуллерена слоя **В** — общего вида, если сравнивать с фуллереном из слоя **A**. Средний радиус заряженного фуллерена равен 3.545 Å, а длины осей аппроксимирующего эллипсоида составляют  $\nu_1 = 3.538$ Å,  $\nu_2 = 3.546$  Å,  $\nu_3 = 3.552$  Å и равноудалены друг от друга по длине (разницы между длинами осей эллипсоида составляют 0.008 Å и 0.006 Å).

На деформационных картах каркаса фуллерена слоя **B** (см. рис. 6 *a*) присутствуют две симметричные выпуклые области около оси  $\nu_3$ , которые напрямую не связаны со статическими янтеллеровскими взаимодействиями, так как не описываются в рамках модели одноосных деформаций (см. рис. 5 *a*). Сложная форма аниона **B** и наличие сильно деформированных областей около оси

ЖЭТФ, том **165**, вып. 4, 2024

 $\nu_3$ , по-видимому, является результатом взаимодействия различных факторов: эффекта кристаллического поля, сформированного компонентами катионных слоев — электростатическим и стерическим влиянием MDABCO<sup>+</sup> и атомов йода (см. рис. 6 б), а также собственными напряжениями в каркасе аниона в виде ян-теллеровских взаимодействий.

О первом факторе — влиянии катионов MDABCO<sup>+</sup> как одной из причин неоднородностей деформированного каркаса — говорит неравномерное распределение заряда на анионе (см. рис. 7). По карте поверхностного заряда видно, что отрицательный заряд фуллерена **B** концентрируется в изолированных областях. Эти области каркаса  $C_{60}^{\bullet-}$  отвечают направлениям на катионы MDABCO<sup>+</sup> и молекулы TPC-I из соседних слоев (см. рис. 6  $\delta$ ).

Рассматривая второй фактор, следует отметить, что возможна ситуация, когда ян-теллеровские искажения имеют динамическую природу. Такие деформации крайне сложно детектировать по структурным данным, однако, динамически искаженные ян-теллеровские анионы, как правило, выделяются из своего кристаллического окружения повышенной степенью структурного беспорядка и подвержены сильным либрациям вследствие так называемого псевдовращения. Следствием псевдоротаций каркасов может быть то, что внутри деформированных областей наблюдаются значительные амплитуды колебаний атомов. В этом плане можно отметить, что среднее, эквивалентное изотропному, квадратичное смещение углеродов фуллерена В заметно выше, чем у фуллерена типа А, а атомы аниона В так же, как и в случае аниона А, претерпевают сильные смещения вдоль поверхности фуллерена, однако форма их тепловых эллипсоидов сильно вытянута вдоль одного из тангенциальных направлений:  $U_{\parallel,1} = 0.236 \text{ Å}^2, U_{\parallel,2} = 0.176 \text{ Å}^2, U_{\perp} = 0.088 \text{ Å}^2$ (см. рис. 6), указывая на либрационные колебания молекулы.

### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе на основе анализа деформаций в каркасах двух кристаллографически независимых анионов фуллерена **A** и **B** в кристаллах соединения  $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I было выявлено, что одноосные искажения анионов первого типа имеют янтеллеровскую природу, в то время как анионы второго типа не имеют выраженного направления искажений, хотя на их каркасах присутствуют области значительных деформаций. Сложная гофрировка каркаса анионов **B** не позволяет классифицировать эти деформации как одномодовые статические ян-теллеровские. Наблюдаемая картина искажений каркаса **B** может быть следствием наложения множества факторов: псевдоротации каркаса из-за так называемого динамического эффекта Яна–Теллера, нетривиального кристаллического поля и др.

Иная ситуация наблюдается с анионами типа А, которые подвержены статическому эффекту Яна-Теллера. Одноосные сонаправленные в слое янтеллеровские деформации  $C_{60}^{\bullet-}$  в **А** препятствуют междоузельной проводимости в фуллереновой подрешетке и могут приводить к частичной диэлектризации слоя. Действительно, анализ зонной структуры слоя А показывает, что анионы слабо связаны друг с другом и скорее ведут себя как ансамбль изолированных спинов S = 1/2. В этом заключается принципиальное различие поведения кристаллов модифицированного ( $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-TPC-I) и исходного составов. Кристаллы исходного состава с незамещенным триптиценом ( $C_{60}^{\bullet-}$ -MDABCO<sup>+</sup>-ТРС-Н) демонстрировали металлический характер спектра электронов соответствующего слоя фуллеренов [10]. Локализованные спины слоя в А проявляют антиферромагнитное взаимодействие, что рождает предпосылки для нетривиальных магнитных эффектов, в частности, может привести к формированию коллективного состояния спиновой жидкости в фрустрированной треугольной подрешетке.

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-23-01158).

# ЛИТЕРАТУРА

- Д.В. Конарев, Р.Н. Любовская, Молекулярный дизайн, исследование структуры и свойств ионных соединений фуллеренов, Успехи химии 4, 336 (2012).
- M. Baumgarten, in: EPR of Free Radicals in Solids II, Trends in Methods and Applications, Prog. T. Chem. (2012), p. 205.
- M. J. Rosseinsky, Fullerene Intercalation Chemistry, J. Mater. Chem. 5, 1497 (1995).
- D. V. Konarev, A.V. Kuzmin, S. V. Simonov et al., Experimental Observation of C<sub>60</sub> LUMO Splitting in the C<sub>60</sub><sup>2-</sup> Dianions Due to the Jahn-Teller Effect. Comparison with the C<sub>60</sub><sup>6-</sup> Radical Anions, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 9136 (2013).

- 5. D. V. Konarev, S. S Khasanov, A. Otsuka et al., Metallic and Mott Insulating Spin-Frustrated Antiferromagnetic States in Ionic Fullerene Complexes with a Two-Dimensional Hexagonal C<sup>6-</sup><sub>60</sub> Packing Motif, Chem. European. J. 20, 7268 (2014).
- D. V. Konarev, S. S. Khasanov, Y. Shimizu et al., Fullerene and Endometallofullerene Kagome Lattices with Symmetry-Forced Spin Frustration, Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 1645 (2018).
- 7. D. V. Konarev, S. S. Khasanov, H. Yamochi, and A. Otsuka, Synthesis, Structure, and Properties of the Fullerene C<sub>60</sub> Salt of Crystal Violet, (CV<sup>+</sup>)(C<sub>60</sub><sup>-</sup>) · 0.5C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>, which Contained Closely Packed Zigzagged C<sub>60</sub><sup>-</sup> Chains, Chem. Asian J. 11, 1705 (2016).
- 8. D. V. Konarev, S. S. Khasanov, A. V. Kuzmin al., *Effective Magnetic*  $\mathbf{et}$ Couplingwith  $(Ph_3MeP^+)(C_{60}^{\bullet-})$ Spin Frustration Strong inand  $Reversible)(C_{60}^{\bullet-})$ Dimerizationin $(Ph_3MeP^+) \cdot (C_{60}^{\bullet-}) \cdot C_6H_5CN$ . Effect of Solvent on Structure and Properties, New J. Chem. 40, 2792 (2016).
- A. Otsuka, D. Konarev, R. Lyubovskaya et al., Design of Spin-Frustrated Monomer-Type C<sup>6−</sup><sub>60</sub> Mott Insulator, Crystals. 8, 115 (2018).

- 10. D. V. Konarev, S. S Khasanov, A. Otsuka et al., A Two-Dimensional Organic Metal Based on Fullerene, Angew. Chem. Int. Ed. 49, 4829 (2010).
- 11. G. Landrum, YAeHMOP 3.0 (2023).
- J. C. Slater, Atomic Shielding Constants, Phys. Rev. 36, 57 (1930)
- E. V. Lenthe and E. J. Baerends, Optimized Slater?Type Basis Sets for the Elements 1–118, J. Comput. Chem. 24, 1142 (2003).
- H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Special Points for Brillouin-Zone Integrations, Phys. Rev. B. 13, 5188 (1976).
- Fullerene-Based Materials: Structures and Properties, ed. by K. Prassides, Springer (2009).
- O. Gunnarsson, Alkali-Doped Fullerides: Narrow-Band Solids with Unusual Properties, World Scientific Publishing Company (2004).
- B. I. Dunlap and R. R. Zope, Efficient Quantum-Chemical Geometry Optimization and the Structure of Large Icosahedral Fullerenes, Chem. Phys. Lett. 422, 451 (2006).
- A. Auerbach, N. Manini, and E. Tosatti, *Electron-Vibron Interactions in Charged Fullerenes. I. Berry Phases*, Phys. Rev. B 49, 12998 (1994).